


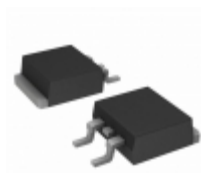

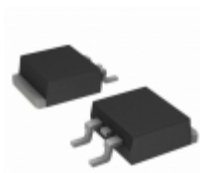




	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB081N06L3 G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB081N06L3 G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB081N06L3 G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 73800 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB081N06L3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB081N06L3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	73800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 34µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.1 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB081N06L3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB081N06L3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB081N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB081N06L3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB081N06L3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3</p>	 <p><b>IPB080N06N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB080N06LG</b> INF IPB080N06LG INF</p>	 <p><b>IPB083N10N3 G</b> Infineon Technologies IPB083N10N3 G Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPB080N03LG</b> VB IPB080N03LG VB</p>	 <p><b>IPB080N06NG</b> VB IPB080N06NG VB</p>	 <p><b>IPB083N10N3G</b> INFINEO IPB083N10N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB080N03LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB081N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB081N06L3 G Datenblatt	IPB081N06L3 G-Datenblätter	IPB081N06L3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB081N06L3 G
IPB081N06L3 G Electronic	IPB081N06L3 G-Komponenten	IPB081N06L3 G-Verteiler	IPB081N06L3 G-Bild	IPB081N06L3 G-Teil
IPB081N06L3 G Preis	IPB081N06L3 G Hersteller	IPB081N06L3 G Bild	IPB081N06L3 G Aktie	IPB081N06L3 G Inventar
IPB081N06L3 G Neu	IPB081N06L3 G Original	IPB081N06L3 G garantiert	IPB081N06L3 G RFQ	IPB081N06L3 G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited